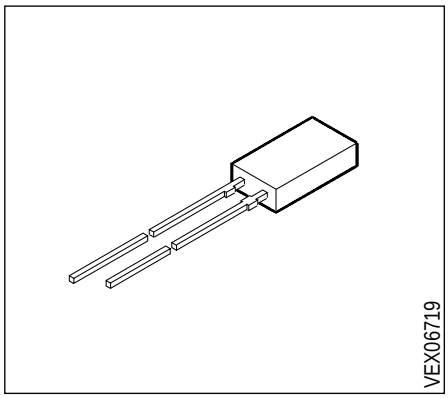
SIEMENS

Symbol LED
5 mm × 2.5 mm, Partly Diffused

LR B480, LS B480, LY B480
LG B480

Besondere Merkmale

- eingefärbtes, teildiffuses Gehäuse
- als optischer Indikator in Frontplatte einsetzbar
- Lötspieße ohne Aufsetzebene
- Bargraphanzeige
- gegurtet lieferbar
- Störimpulsfest nach DIN 40839



Features

- colored, partly diffused package
- for use as optical indicator in frontpanel
- solder leads without stand-off
- Bargraph displays
- available taped on reel
- load dump resistance acc. to DIN 40839

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Gehäusefarbe Color of Package	Lichtstärke Luminous Intensity I_F = 10 mA I_V (mcd)	Bestellnummer Ordering Code
LR B480-BD	red	red, partly diffused	0.16 … 0.80	Q62703-Q1464
LR B480-C			0.25 … 0.50	Q62703-Q1465
LR B480-D			0.40 … 0.80	Q62703-Q2648
LR B480-CE			0.25 … 1.25	Q62703-Q3841
LS B480-EH	super-red	red, partly diffused	0.63 … 5.00	Q62703-Q1466
LS B480-G			1.60 … 3.20	Q62703-Q1467
LS B480-H			2.50 … 5.00	Q62703-Q1468
LS B480-GK			1.60 … 12.50	Q62703-Q1469
LY B480-EH	yellow	yellow, partly diffused	0.63 … 5.00	Q62703-Q1470
LY B480-G			1.60 … 3.20	Q62703-Q1471
LY B480-H			2.50 … 5.00	Q62703-Q2006
LY B480-J			4.00 … 8.00	Q62703-Q1473
LY B480-GK			1.60 … 12.50	Q62703-Q2007
LG B480-EH	green	green, partly diffused	0.63 … 5.00	Q62703-Q1477
LG B480-G			1.60 … 3.20	Q62703-Q1870
LG B480-H			2.50 … 5.00	Q62703-Q2025
LG B480-GK			1.60 … 12.50	Q62703-Q2026

Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit $I_{V\,max} / I_{V\,min} \leq 2.0$.
Luminous intensity ratio in one packaging unit $I_{V\,max} / I_{V\,min} \leq 2.0$.

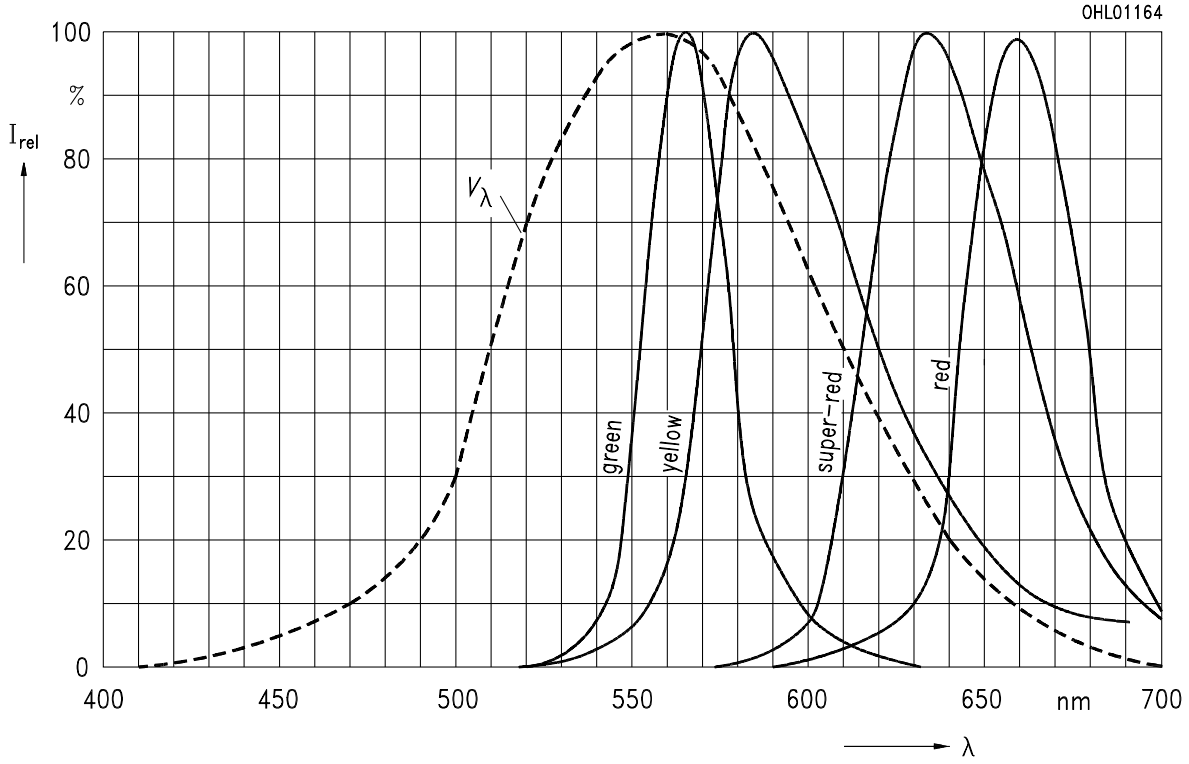
Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung **Parameter**	**Symbol** **Symbol**	**Werte** **Values**		**Einheit** **Unit**
		LR	**LS, LY, LG**	
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	– 55 … + 100		°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	– 55 … + 100		°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 100		°C
Durchlaßstrom Forward current	I_F	45	40	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10$ µs, $D = 0.005$	I_{FM}	0.5		A
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5		V
Verlustleistung Power dissipation $T_A \leq 25$ °C	P_{tot}	100	140	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Luft Junction / air	$R_{th\ JA}$	400		K/W

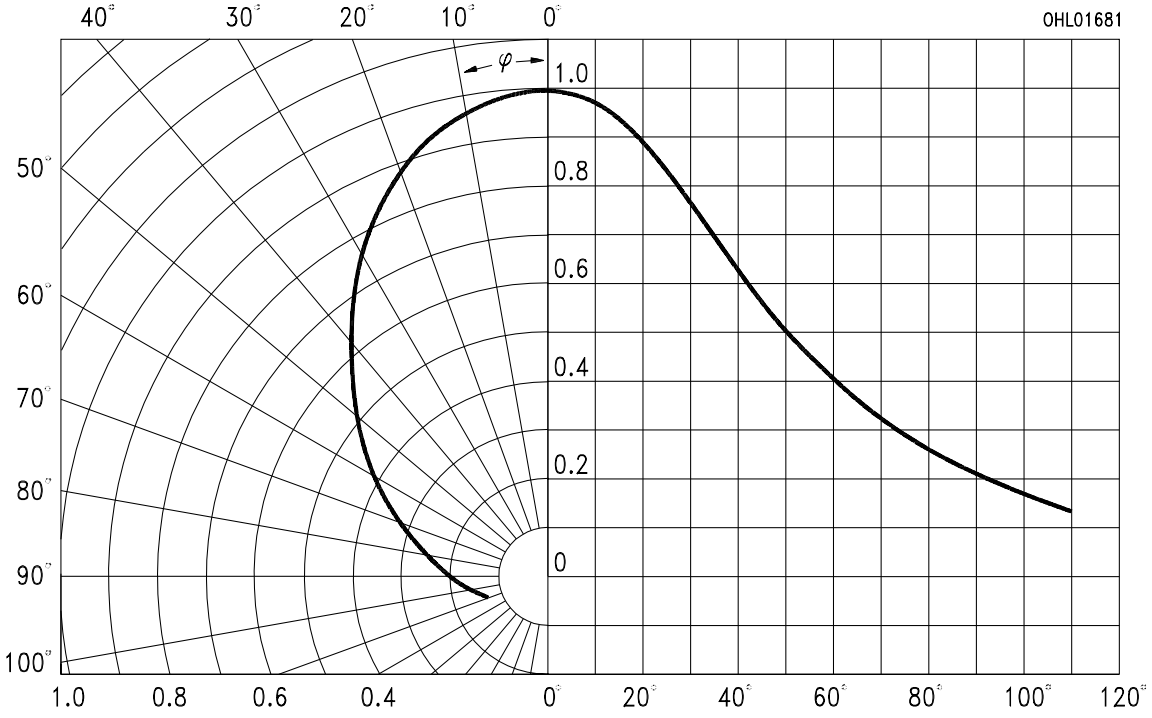
Kennwerte (T_A = 25 ˚C)
Characteristics

Bezeichnung **Parameter**		**Symbol** **Symbol**	**Werte** **Values**				**Einheit** **Unit**
			LR	**LS**	**LY**	**LG**	
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission I_F = 20 mA	(typ.) (typ.)	λ_{peak}	660	635	586	565	nm
Dominantwellenlänge Dominant wavelength I_F = 20 mA	(typ.) (typ.)	λ_{dom}	645	628	590	570	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{rel\ max}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{rel\ max}$ I_F = 20 mA	(typ.) (typ.)	$\Delta\lambda$	35	45	45	25	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V		2φ	100	100	100	100	Grad deg.
Durchlaßspannung Forward voltage I_F = 10 mA	(typ.) (max.)	V_F V_F	1.6 2.0	2.0 2.6	2.0 2.6	2.0 2.6	V V
Sperrstrom Reverse current V_R = 5 V	(typ.) (max.)	I_R I_R	0.01 10	0.01 10	0.01 10	0.01 10	µA µA
Kapazität Capacitance V_R = 0 V, f = 1 MHz	(typ.)	C_0	25	12	10	15	pF
Schaltzeiten: Switching times: I_V from 10 % to 90 % I_V from 90 % to 10 % I_F = 100 mA, t_P = 10 µs, R_L = 50 Ω	 (typ.) (typ.)	 t_r t_f	 120 50	 300 150	 300 150	 450 200	 ns ns

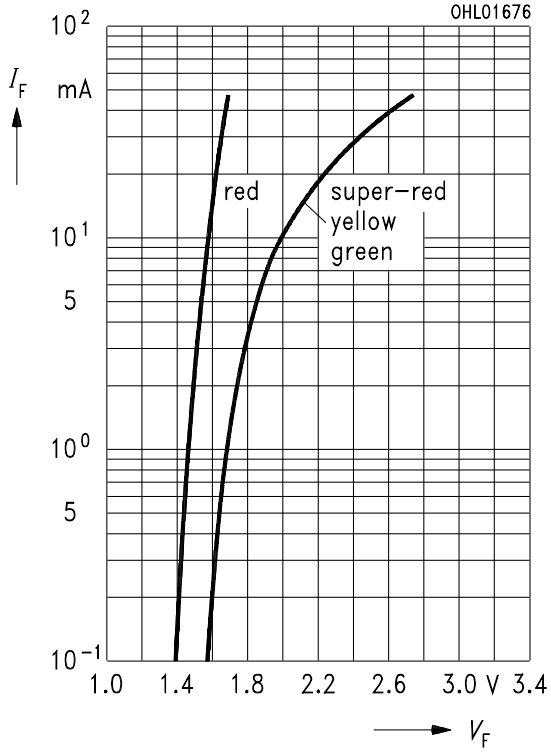
Relative spektrale Emission $I_{rel} = f(\lambda)$, T_A = 25 ˚C, I_F = 20 mA
Relative spectral emission
V (λ) = spektrale Augenempfindlichkeit
Standard eye response curve



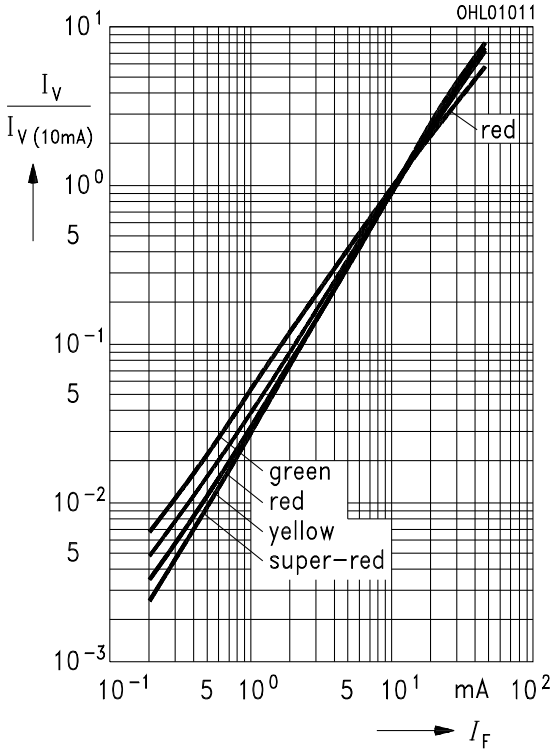
Abstrahlcharakteristik $I_{rel} = f(\varphi)$
Radiation characteristic



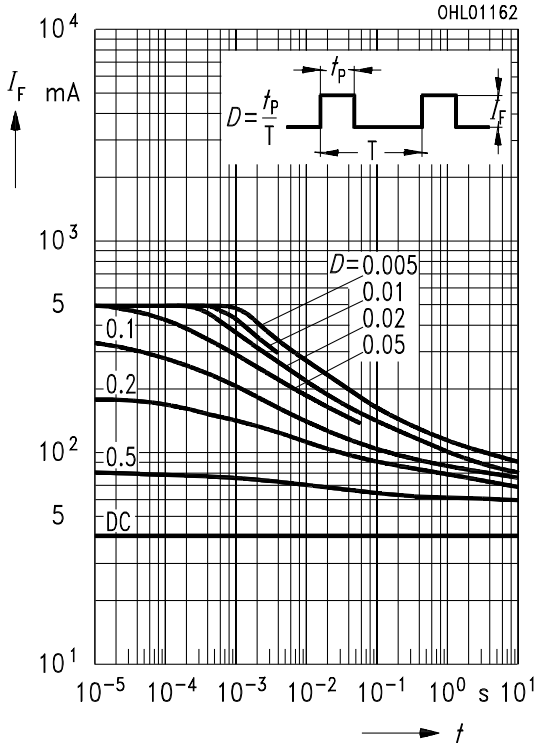
Durchlaßstrom $I_F = f(V_F)$
Forward current
T_A = 25 ℃



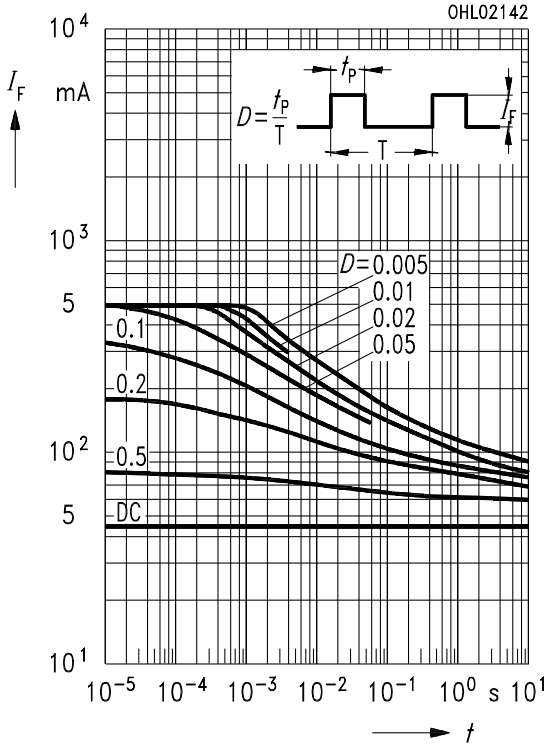
Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(10\ mA)} = f(I_F)$
Relative luminous intensity
T_A = 25 ℃



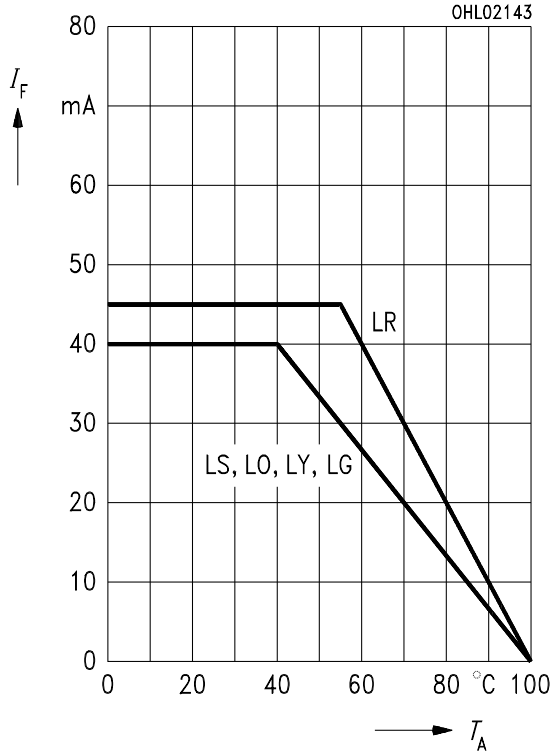
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_P)$
Permissible pulse handling capability
Duty cycle D = parameter, T_A = 25 ℃
LS, LY, LG



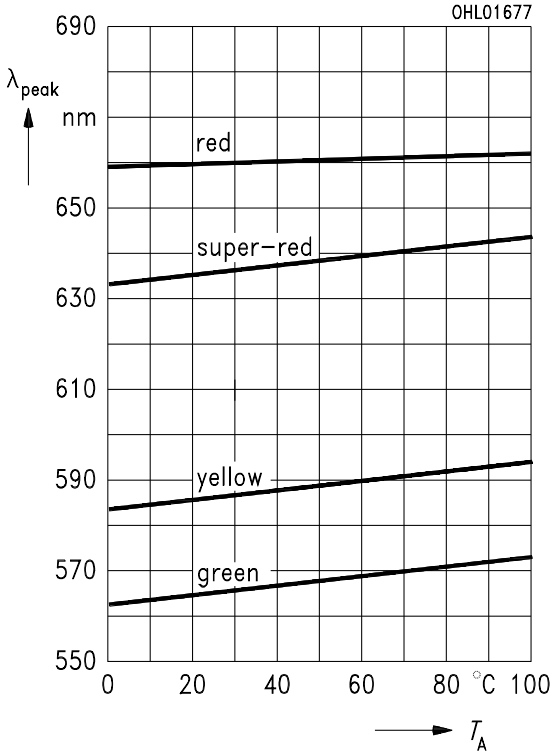
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_P)$
Permissible pulse handling capability
Duty cycle D = parameter, T_A = 25 ℃
LR



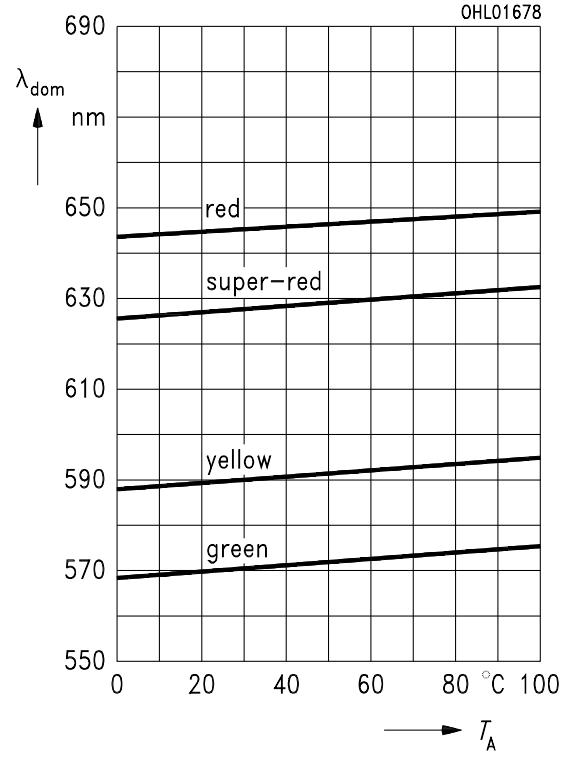
Maximal zulässiger Durchlaßstrom
Max. permissible forward current
$I_F = f(T_A)$



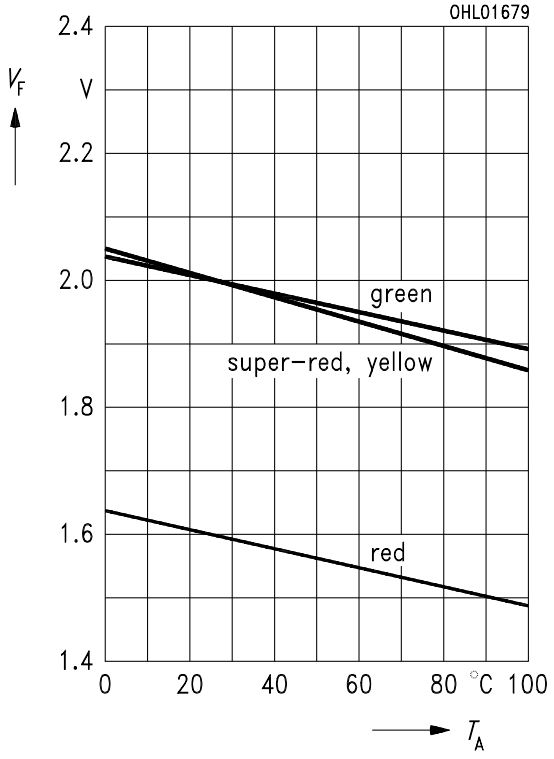
Wellenlänge der Strahlung $\lambda_{peak} = f(T_A)$
Wavelength at peak emission
I_F = 20 mA



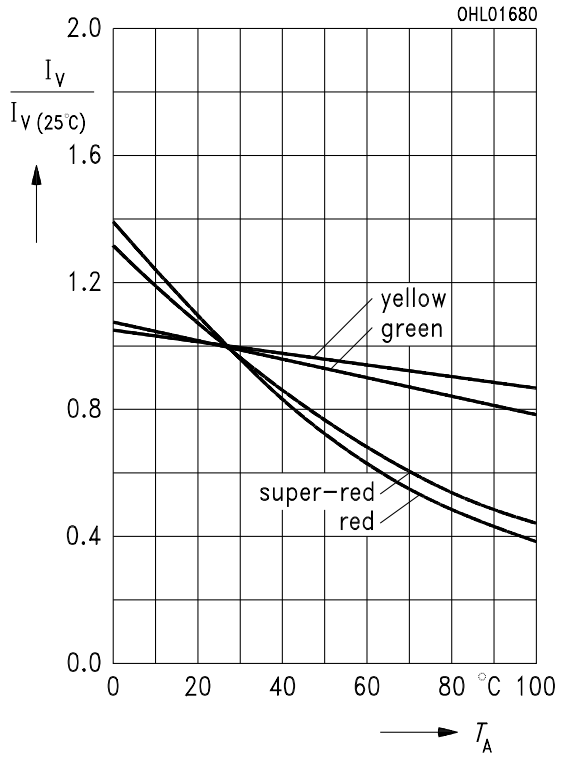
Dominantwellenlänge $\lambda_{dom} = f(T_A)$
Dominant wavelength
I_F = 20 mA



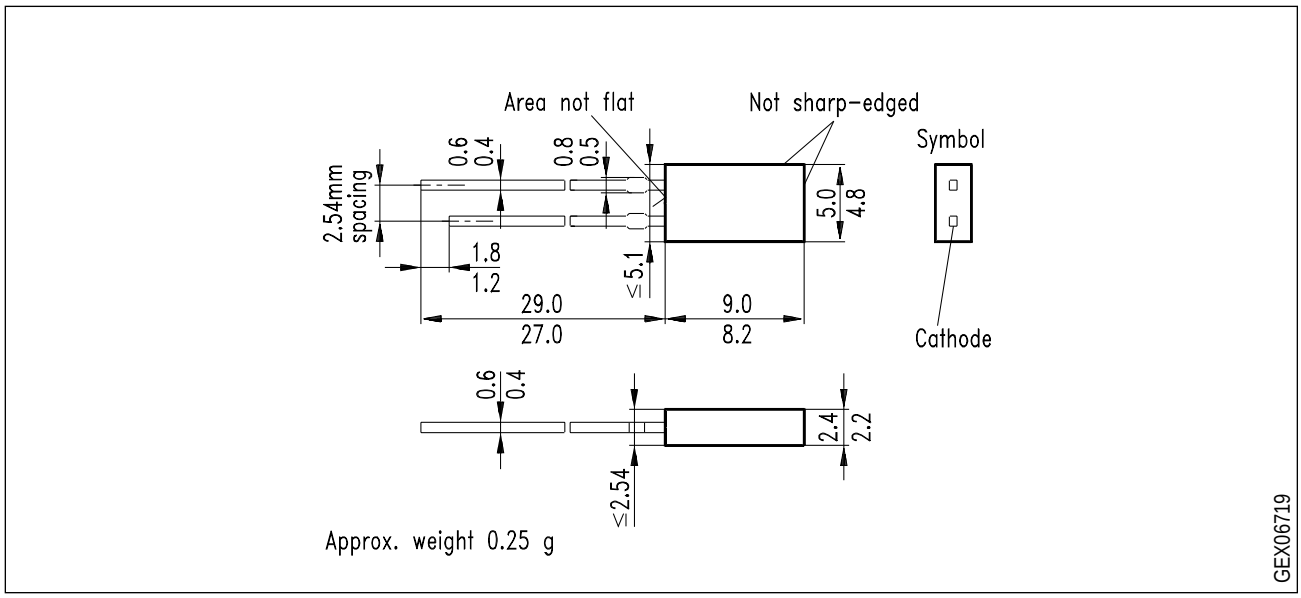
Durchlaßspannung $V_F = f(T_A)$
Forward voltage
I_F = 10 mA



Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(25\,°C)} = f(T_A)$
Relative luminous intensity
I_F = 10 mA



Maßzeichnung (Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)
Package Outlines (Dimensions in mm, unless otherwise specified)



Kathodenkennzeichnung: Kürzerer Lötspieß
Cathode mark: Short solder lead

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9